

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年3月8日(2007.3.8)

【公開番号】特開2004-235632(P2004-235632A)

【公開日】平成16年8月19日(2004.8.19)

【年通号数】公開・登録公報2004-032

【出願番号】特願2004-15250(P2004-15250)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

C 23 C 16/34 (2006.01)

H 01 S 5/125 (2006.01)

H 01 S 5/323 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

C 23 C 16/34

H 01 S 5/125

H 01 S 5/323 6 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月18日(2007.1.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも1つのIII族元素と、窒素と、少なくとも1つのV族元素とを構成元素として含む半導体材料の層を成長させる方法であって、該方法は、

リアクターを用意するステップと、前記リアクターへと前駆物質を供給するステップとを有し、該前駆物質は、

前記少なくとも1つのIII族元素用の前駆物質と、

窒素用の前駆物質と、

窒素以外の前記少なくとも1つのV族元素用の前駆物質と、

前記少なくとも1つのIII族元素が窒素に対して持つよりも強い結合強度を窒素に対して持つ元素用の前駆物質とを含み、

前記強い結合強度を窒素に対して持つ元素の前駆物質は、ホウ素原子を有する前駆物質とシリコン原子を有する前駆物質から成るグループから選択される、前記方法。

【請求項2】

前記リアクターが、有機金属化学蒸着用のリアクターである請求項1に記載の方法。